

Silicon Diode

BAV102

200V / 250mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

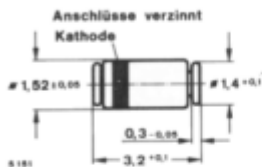
Source: Telefunken Databook 1985&88

BAV 100 bis BAV 103

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode

Anwendungen: Allgemein

Abmessungen in mm



SOD 80
MiniMELF
Gewicht max. 0,1 g

Bestempelung: Körperfarbe blau. Kathodenring schwarz. Zusätzliche Farbringe für:

BAV 100 braun
BAV 101 braun, schwarz, braun
BAV 102 braun, schwarz, rot
BAV 103 braun, schwarz, orange

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung	BAV 100	U_R	60	V
	BAV 101	U_R	120	V
	BAV 102	U_R	200	V
	BAV 103	U_R	250	V
Durchlaßstrom		I_F	250	mA
Stoßdurchlaßstrom $t_p \leq 1 \text{ s}, T_j = 25 \text{ °C}$		I_{FSM}	1	A
Spitzendurchlaßstrom $f = 50 \text{ Hz}$		I_{FM}	625	mA
Sperrschichttemperatur		T_j	175	°C
Lagerungstemperaturbereich		T_{stg}	- 65... + 175	°C

Wärmewiderstand

	Min.	Typ.	Max.	
Sperrschicht - Umgebung auf Leiterplatte 50x50x1,6 mm			500	K/W
				R_{thJA}

BAV 100 bis BAV 103

		Min.	Typ.	Max.
Kenngrößen				
$T_j = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben				
Durchlaßspannung				
$I_F = 100\text{ mA}$	U_F			1 V
Sperrstrom				
$U_R = 50\text{ V}$	BAV 100	I_R		100 nA
$U_R = 100\text{ V}$	BAV 101	I_R		100 nA
$U_R = 150\text{ V}$	BAV 102	I_R		100 nA
$U_R = 200\text{ V}$	BAV 103	I_R		100 nA
$T_j = 100\text{ °C}$				
$U_R = 50\text{ V}$	BAV 100	I_R		15 μA
$U_R = 100\text{ V}$	BAV 101	I_R		15 μA
$U_R = 150\text{ V}$	BAV 102	I_R		15 μA
$U_R = 200\text{ V}$	BAV 103	I_R		15 μA
Durchbruchspannung				
$I_R = 100\text{ }\mu\text{A}$	BAV 100	$U_{(BR)}^{1)}$	60	V
	BAV 101	$U_{(BR)}^{1)}$	120	V
	BAV 102	$U_{(BR)}^{1)}$	200	V
	BAV 103	$U_{(BR)}^{1)}$	250	V
Diodenkapazität				
$U_R = 0, f = 1\text{ MHz}$	C_D		1,5	pF
Differenzieller Durchlaßwiderstand				
$I_F = 10\text{ mA}$	r_f		5	Ω
Rückwärtserholzeit				
$I_F = I_R = 30\text{ mA}, I_R = 3\text{ mA}, R_L = 100\text{ }\Omega$	t_{rr}			50 ns

¹⁾ $t_D = 0,01, t_D = 0,3\text{ ms}$